



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Campus Saltillo

"REPORTE PRÁCTICA 3"

Materia: Arquitectura de Computadoras

Maestro: Miguel Maldonado Leza

Alumna: Arely Jaqueline Zuñiga Ramirez

Numero de control: 22050756

Saltillo, Coahuila

Memoria RAM Samsung M378B5673FHD-CH9

Características Generales:

• Marca: Samsung

Modelo: M378B5673FHO-CH9

• Tipo de memoria: DDR3 SDRAM

Capacidad: 2 GB

• Formato: DIMM de 240 pines

• **Voltaje**: 1.5 V

• Clasificación: No-ECC (sin corrección de errores)

• **Tipo de módulo**: Unbuffered (sin búfer)

• Clasificación de latencia (CAS): CL9 (9-9-9)

Rango: Dual Rank (2R)

Organización de chips: 128x8

Cumple con estándares: RoHS, libre de plomo y halógenos

Especificaciones Técnicas:

Tecnología: DDR3 SDRAM

• **Frecuencia**: 1333 MHz (PC3-10600)

Ancho de banda: 10.6 GB/s

• Tiempo de ciclo: 1.5 ns

• Número de pines: 240

• **Tipo de bus**: PC3-10600

• **Tipo de señal**: No-ECC (sin corrección de errores)

• **Tipo de memoria**: Unbuffered (sin búfer)

• Clasificación de latencia (CAS): CL9 (9-9-9)

• Rango: Dual Rank (2R)

• **Voltaje**: 1.5 V

• Cumple con estándares: RoHS, libre de plomo y halógenos

Otras Características:

- Compatibilidad: Compatible con sistemas que admiten memoria DDR3 SDRAM de 1333 MHz y 240 pines.
- **Uso recomendado**: Ideal para actualizaciones de memoria en computadoras de escritorio que requieren módulos DDR3 de 2 GB con especificaciones estándar.



Memoria RAM Kingston KVR1333D3S8N9/2G

Características Generales:

Marca: Kingston

Modelo: KVR1333D3S8N9/2G

Tipo de memoria: DDR3 SDRAM

• Capacidad: 2 GB

• Formato: DIMM de 240 pines

• **Voltaje**: 1.5 V

• Clasificación: No-ECC (sin corrección de errores)

• **Tipo de módulo:** Unbuffered (sin búfer)

• Clasificación de latencia (CAS): CL9 (9-9-9)

• Rango: Single Rank (1R)

• Organización de chips: 256M x 64

Cumple con estándares: RoHS, libre de plomo y halógenos

Especificaciones Técnicas:

Tecnología: DDR3 SDRAM

• **Frecuencia**: 1333 MHz (PC3-10600)

Ancho de banda: 10.6 GB/s

• Tiempo de ciclo: 1.5 ns

• Número de pines: 240

• Tipo de bus: PC3-10600

• **Tipo de señal**: No-ECC (sin corrección de errores)

• **Tipo de memoria**: Unbuffered (sin búfer)

• Clasificación de latencia (CAS): CL9 (9-9-9)

• Rango: Single Rank (1R)

Voltaje: 1.5 V

Cumple con estándares: RoHS, libre de plomo y halógenos

Otras Características:

- Compatibilidad: Compatible con sistemas que admiten memoria DDR3 SDRAM de 1333 MHz y 240 pines.
- **Uso recomendado**: Ideal para actualizaciones de memoria en computadoras de escritorio que requieren módulos DDR3 de 2 GB con especificaciones estándar.



Memoria RAM Nanya NT2GC64B88BONF-CG

Características Generales:

Marca: Nanya

Modelo: NT2GC64B88BONF-CG

• Tipo de memoria: DDR3 SDRAM

• Capacidad: 2 GB

• Formato: DIMM de 240 pines

• **Voltaje**: 1.5 V

• Clasificación: No-ECC (sin corrección de errores)

• **Tipo de módulo**: Unbuffered (sin búfer)

• Clasificación de latencia (CAS): CL9 (9-9-9)

• Rango: Single Rank (1R)

• Organización de chips: 256x64

Cumple con estándares: RoHS, libre de plomo y halógenos

Especificaciones Técnicas:

Tecnología: DDR3 SDRAM

• **Frecuencia**: 1333 MHz (PC3-10600)

• Ancho de banda: 10.6 GB/s

• Tiempo de ciclo: 1.5 ns

• Número de pines: 240

• **Tipo de bus**: PC3-10600

• Tipo de señal: No-ECC (sin corrección de errores)

• **Tipo de memoria**: Unbuffered (sin búfer)

• Clasificación de latencia (CAS): CL9 (9-9-9)

• Rango: Single Rank (1R)

• **Voltaje**: 1.5 V

Cumple con estándares: RoHS, libre de plomo y halógenos

Otras Características:

- Compatibilidad: Compatible con sistemas que admiten memoria DDR3 SDRAM de 1333 MHz y 240 pines.
- **Uso recomendado**: Ideal para actualizaciones de memoria en servidores que requieren módulos DDR3 de 2 GB con especificaciones estándar.

